


# 第15回 ナノ構造エピタキシャル成長講演会

日本結晶成長学会 ナノ構造・エピタキシャル成長分科会 主催

 **日時**：2023年6月15日(木)–17日(土)

 **場所**：山形テルサ アプローチ&ホワイエ

(山形市, JR山形駅から徒歩10分)

本講演会では, 様々な半導体およびナノ構造のエピタキシャル結晶成長技術の動向を総合的かつ俯瞰的に討論し, 結晶成長科学の理解を深めるとともに, 若手研究者の育成を目指しております. 半導体材料の結晶成長と, それに関連した成長技術, 特性評価, デバイス作製・評価等の技術に関して議論を行います.



## プログラム

### 基調講演

川上 養一 先生 (京都大学) 「窒化物半導体を用いた発光シンセサイザ開発の現状と展望」

### チュートリアル講演

秩父 重英 先生 (東北大学) 「空孔複合体が(AI,Ga)Nの発光特性に与える影響」

東脇 正高 先生 (大阪公立大学) 「酸化ガリウム：材料・デバイス技術の現在地」

### 招待講演

大西 一生 先生 (名古屋大学) 「縦型パワーデバイス用途に向けたGaNのHVPE成長」

後藤 健 先生 (東京農工大学) 「MOVPE法による高純度 $\beta$ -Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>結晶成長の化学反応メカニズム」

舘林 潤 先生 (大阪大学) 「次世代ディスプレイ実現に向けたEu添加GaNナノワイヤの結晶成長」

永村 直佳 先生 (NIMS) 「半導体デバイス構造のオペランド分光計測とインフォマティクスの活用」

堀田 昌宏 先生 (名古屋大学)

前田 拓也 先生 (東京大学) 「パワーデバイス応用に向けたGaNの高電界物性評価」

### ポスター講演 (一般公演)

投稿募集中! [締切: 5月12日(金)]

ナノ構造エピタキシャル成長講演会のHP<https://sites.google.com/view/nanoepi/event>  
または右のQRコードからご投稿ください.



## 実行委員会

- ・実行委員長：大音 隆男 (山形大学)
- ・現地委員：成田 克 (山形大学)
- ・会計委員：河村 貴宏 (三重大学)
- ・プログラム委員長：荒木 努 (立命館大学)
- ・プログラム副委員長：村上 尚 (東京農工大学)
- ・展示委員：出浦 桃子 (立命館大学)
- ・世話人：岩谷 素顕 (名城大学), 三宅 秀人 (三重大学)  
藤岡 洋 (東京大学)

## 問い合わせ先

山形大学 大音 隆男  
t-oto@yz.yamagata-u.ac.jp

企業展示に関する問い合わせ **出展募集中! [締切: 5月19日(金)]**

立命館大学 出浦 桃子  
deura@fc.ritsumeai.ac.jp

※ 右のQRコードから申込書をダウンロードできます.

